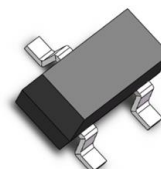


LYNM0100S1P 型 N 沟道 MOS 场效应晶体管

1 特性

- 开关速度快，输入阻抗高；
- 安全工作区宽，温度稳定性好；
- 静电敏感等级：1B；
- 封装形式：S0T-23；



2 质量等级及执行标准

G 级：QZJ840611，Q/RBJ1019QZ-2015。

3 最大额定值

最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

参数 产品型号	P_D (W)	BV_{DSS} (V)	V_{GS} (V)	I_D (A)	$R_{DS(on)}$ (m Ω)	$R_{th(j-A)}$ ($^{\circ}\text{C}/\text{W}$)	T_j ($^{\circ}\text{C}$)	T_{stg} ($^{\circ}\text{C}$)
LYNM0100S1P	1.3	100	± 16	1.6	300	100	$-55\sim 150$	$-55\sim 150$

4 主要电特性

主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

序号	参数名称	符号	测试条件	规范值		单位
				最小值	最大值	
1	漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}$, $I_D=250\mu\text{A}$	100	—	V
2	零栅压漏极电流	I_{DSS1}	$V_{DS}=100\text{V}$, $V_{GS}=0\text{V}$	—	20	μA
		I_{DSS2}	$V_{DS}=100\text{V}$, $V_{GS}=0\text{V}$, $T_j=125^{\circ}\text{C}$	—	250	μA
3	正向栅极漏电流	I_{GSSF}	$V_{GS}=16\text{V}$, $V_{DS}=0\text{V}$	—	100	nA
4	反向栅极漏电流	I_{GSSR}	$V_{GS}=-16\text{V}$, $V_{DS}=0\text{V}$	—	-100	nA
5	开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}$, $I_D=25\mu\text{A}$	1.0	2.5	V
6	导通电阻	$R_{DS(on)1}$	$V_{GS}=10\text{V}$, $I_D=1.6\text{A}$	—	300	m Ω
		$R_{DS(on)2}$	$V_{GS}=4.5\text{V}$, $I_D=1.3\text{A}$	—	350	m Ω
7	跨导	g_{fs}	$V_{DS}=50\text{V}$, $I_D=1.6\text{A}$	5.7	—	

8	电容	C_{ISS}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	—	400	pF
		C_{OSS}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	—	60	pF
		C_{RSS}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	—	40	pF

5 特性曲线

5.1 不同栅源电压、不同漏源电压下的漏极电流曲线

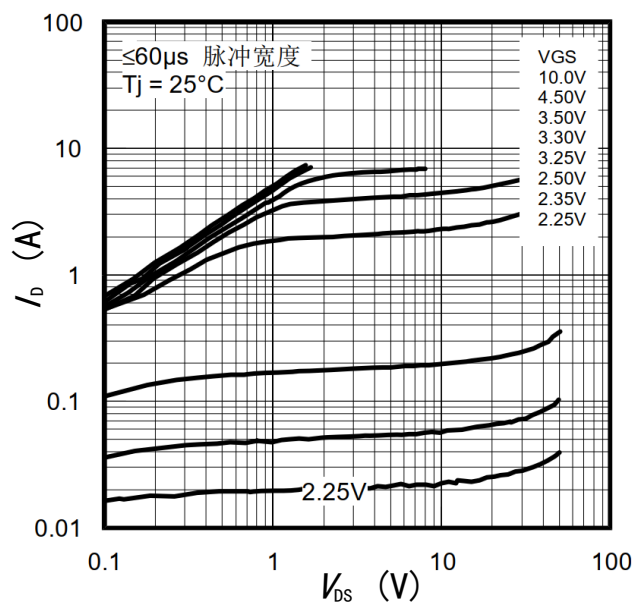


图 1 开启区域特性曲线

5.2 不同温度、不同栅源电压下的漏极电流曲线

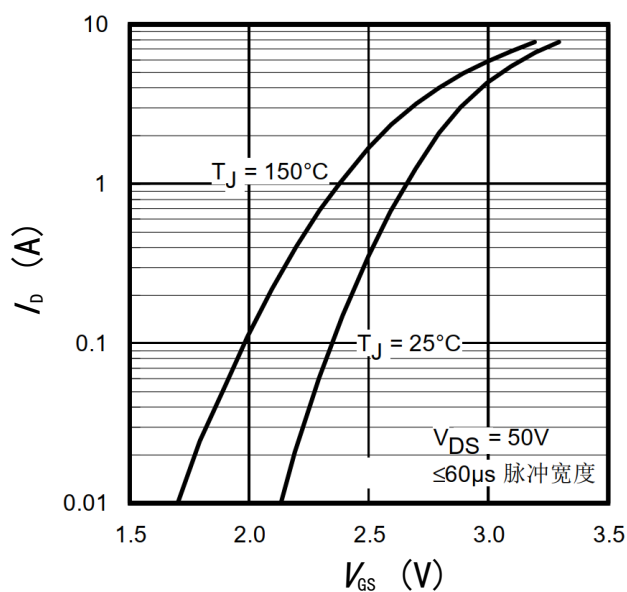
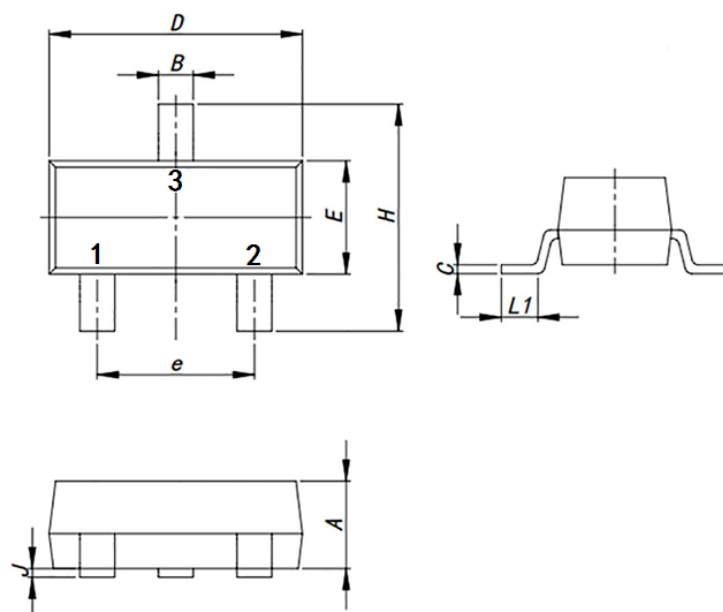


图 2 转移特性曲线

6 外形尺寸



引出端：1-栅极 G，2-源极 S，3-漏极 D

图 3 SOT-23 外形尺寸图

单位:mm

符号 尺寸	A	B	C	D	E	e	J	H	L_1
最小值	0.90	0.30	0.08	2.70	1.20	1.70	—	2.20	0.15
最大值	1.30	0.50	0.18	3.10	1.60	2.10	0.10	3.00	0.45